

2 N 915

Nicht für Neuentwicklungen

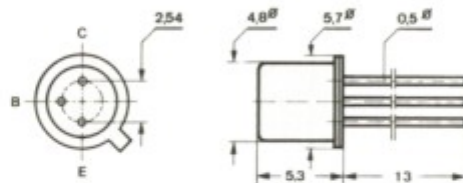
Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor für HF-Verstärker und Oszillatoren sowie für nicht gesättigten Schalterbetrieb.

Silicon NPN planar RF transistor for non-saturating switching circuits, RF amplifiers and oscillator circuits.

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm

M 2:1



Kollektor mit Gehäuse verbunden
Collector is connected to case

Normgehäuse
DIN 18 A 3
JEDEC TO 18
Gewicht · Weight
max. 0,5 g

Zubehör · Accessories

Zwischensockel Ident-Nr. 009010

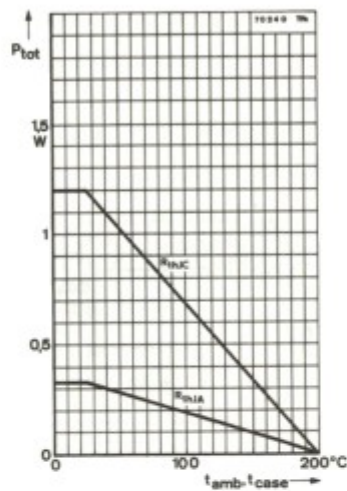
Absolute Grenzdaten · Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung	U_{CBO}	70	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	U_{CEO}	50	V
Emitter-Basis-Sperrspannung	U_{EBO}	5	V
Gesamtverlustleistung $t_{amb} \leq 45^\circ\text{C}$	P_{tot}	320	mW
Sperrschichttemperatur	t_j	200	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperatur	t_{stg}	-65... + 200	$^\circ\text{C}$



2 N 915**Wärmewiderstände · Thermal resistances**

Sperrschicht-Umgebung	R_{thJA}	\leq 490	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Sperrschicht-Gehäuse	R_{thJC}	\leq 146	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

**Kenngrößen · Characteristics**

Umgebungstemperatur $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.
Kollektorruhestrom				
$U_{CB} = 60\text{ V}$	$I_{CBO}^{*)}$			10 nA
$U_{CB} = 60\text{ V}, t_{amb} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{CBO}^{**)}$			30 μA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung	$U_{(BR)CBO}^{*)}$	70		V
$I_C = 0,1\text{ mA}$				
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$U_{(BR)CEO}^{*) 1)}$	50		V
$I_C = 10\text{ mA}$				
Kollektor-Sättigungsspannung	U_{CEsat}			1 V
$I_C = 10\text{ mA}, I_B = 1\text{ mA}$				
Basis-Sättigungsspannung	U_{BEsat}			0,9 V
$I_C = 10\text{ mA}, I_B = 1\text{ mA}$				
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis	$h_{FE}^{1)}$	40		160
$U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}$				
Transit-Frequenz	f_T	250		MHz
$U_{CE} = 15\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$				
Kollektor-Basis-Kapazität	C_{CBO}			3,5 pF
$U_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0\text{ mA}, f = 1\text{ MHz}$				

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, 1) impulsmäßig gemessen: $t_p = 0,01, t_p \leq 0,3\text{ ms}$

